









	<h2 style="color: #e67e22;">R6020ANJTL</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">R6020ANJTL</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">R6020ANJTL.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">R6020ANJTL</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-83
Supplier Device-Gehäuse	LPTS
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	250 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2040pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)












R6020ANJTL ist neu im Original, Suche R6020ANJTL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie R6020ANJTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage R6020ANJTL: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>R6020825HSYA</b> Powerex, Inc. DIODE GEN PURP 800V 250A DO205AB</p>	 <p><b>R6020835ESYA</b> Powerex, Inc. DIODE GEN PURP 800V 350A DO205AB</p>	 <p><b>R6020ENJTL</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A LPT</p>	 <p><b>R6020635ESYA</b> Powerex, Inc. DIODE GEN PURP 600V 350A DO205AB</p>
 <p><b>R6020ANJ</b> ROHM R6020ANJ ROHM</p>	 <p><b>R6020ANZC8</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO3PF</p>	 <p><b>R6020ANZ</b> ROHM R6020ANZ ROHM</p>	 <p><b>R6020ANX</b> LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A TO-220FM</p>

### heiße Teile

Mehr

 R6001430XXYA	 R6001620XXYA	 R6001625XXYA	 R6001630XXYA	 R6001820XXYA
 R6001825XXYA	 R6004CND	 R6004CNDTL	 R6004END	 R6004ENJ
 R6004ENX	 R6006ANDTL	 R6006ANX	 R6007ENJ	 R6007ENX
 R6008ANJ	 R6008ANX	 R6008FNJ	 R6008FNJTL	 R600CH16FW0
 R600CH16FY0	 R600CH18	 R600CH18C2G0	 R600CH18D2G0	 R600CH18D2H0
 R600CH18FY0	 R600CH20	 R600CH20F2G0	 R600CH20FF0	 R600CH20FW0
 R600CH20FY0	 R600CH21	 R600CH21C2G0	 R600CH21C2H0	 R600CH25
 R600CH25F2HD	 R600DH25F2G2	 R6010830XXYA	 R6010830XXYA	 R6011ENX
 R6012630YA	 R6015ANZ	 R6020ANZ	 R6020ANZFU7C8	 R6020ENXC7
 R6025ANZ	 R6046ANZ1	 R60S1215	 R60S1215TS	 R60S4821-1TS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited